

Title (en)

GATE DIELECTRIC FOR A THIN FILM FIELD EFFECT TRANSISTOR.

Title (de)

DIELEKTRISCHES TOR FÜR EINEN DÜNNFILMFELDEFFEKTTRANSISTOR.

Title (fr)

PORTE DIELECTRIQUE POUR TRANSISTOR A EFFET DE CHAMP A FILM MINCE.

Publication

**EP 0408653 A1 19910123 (EN)**

Application

**EP 89904998 A 19890314**

Priority

US 17626488 A 19880331

Abstract (en)

[origin: WO8909494A1] A thin film field effect transistor utilizes a double-layer of dielectric material with a first layer (14) of an insulating crystalline or amorphous material and a second layer (16) of silicon nitride. The first layer has a high dielectric constant and the second layer eliminates pinholes which could occur in the first layer.

Abstract (fr)

Un transistor à effet de champ à film mince utilise une double couche de matériau diélectrique, la première couche (14) étant constituée d'un cristallin ou d'un matériau amorphe isolant et la deuxième (16) d'azoture de silicium. La première couche comporte une constante diélectrique élevée et la seconde élimine les trous qui pourraient se former sur la première couche.

IPC 1-7

**H01L 27/12; H01L 29/34; H01L 29/78**

IPC 8 full level

**H01L 29/49** (2006.01)

CPC (source: EP)

**H01L 29/4908** (2013.01)

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE FR GB IT LI LU NL SE

DOCDB simple family (publication)

**WO 8909494 A1 19891005**; EP 0408653 A1 19910123; EP 0408653 A4 19911016

DOCDB simple family (application)

**US 8900971 W 19890314**; EP 89904998 A 19890314